

※課題番号 : FA-F-12-0011
※支援課題名 (日本語) : マイクロバンプめっきの検討
※Program Title (in English) : Examination of microbump plating
※利用者名 (日本語) : 西 弘敏、尾前 聡一郎
※Username (in English) : Hirotoshi NISHI、Soichiro OMAE
※所属名 (日本語) : 株式会社 新菱 ウェハテクノ事業部門 技術開発室
※Affiliation (in English) : Shinryo Corporation Wafer-Techno Business Division Technical Development Group

※概要 (Summary) :

今後、微細化が望まれるフリップチップ実装向けのバンプ形成について、検討を行っている。めっき技術検討に加え、めっきの前後工程であるレジスト加工、レジスト剥離、エッチングについても検討を行っている。

※その他・特記事項 (Others) :

特になし

共同研究者等 (Coauthor) :

なし

※実験 (Experimental) :

2012 年度使用装置

- ・ RIE : レジストの残渣処理を目的として条件を検討している。
- ・ SEM-EDS : バンプの外観観察と解析に使用。

論文・学会発表

(Publication/Presentation) :

なし

関連特許 (Patent) :

なし

※結果と考察 (Results and Discussion) :

(1)RIE

RIE による酸素プラズマ処理の効果により、レジスト残渣が除去され、めっきの未着やバンプ形状異常の発生を抑制できることが分かった。また、エッチング残りの抑制についても効果があることが分かった。

現在、4 インチ→8 インチへの大口径にて検討を継続していくとともに処理後のレジスト (バンプ) 形状の変化についても検証を進めている。